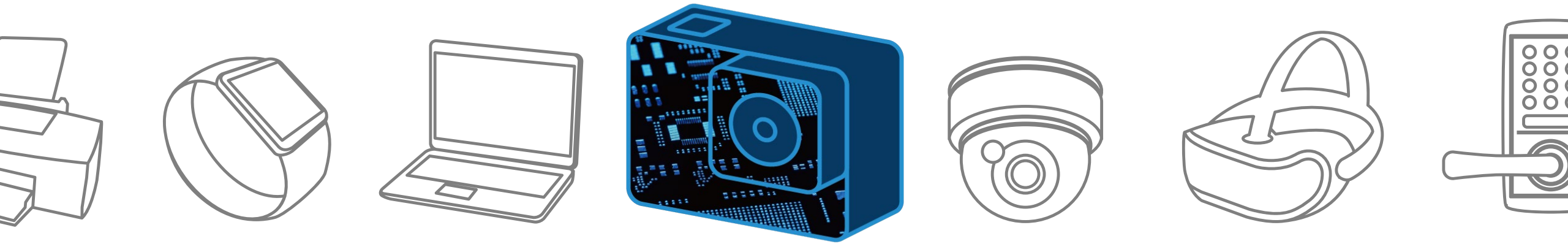
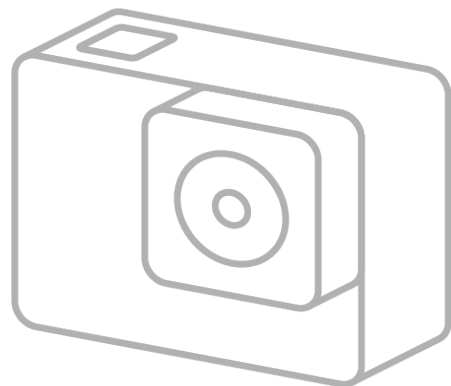
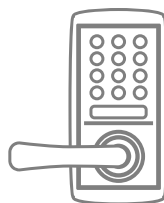


Action Camera

Solution Proposal by Toshiba

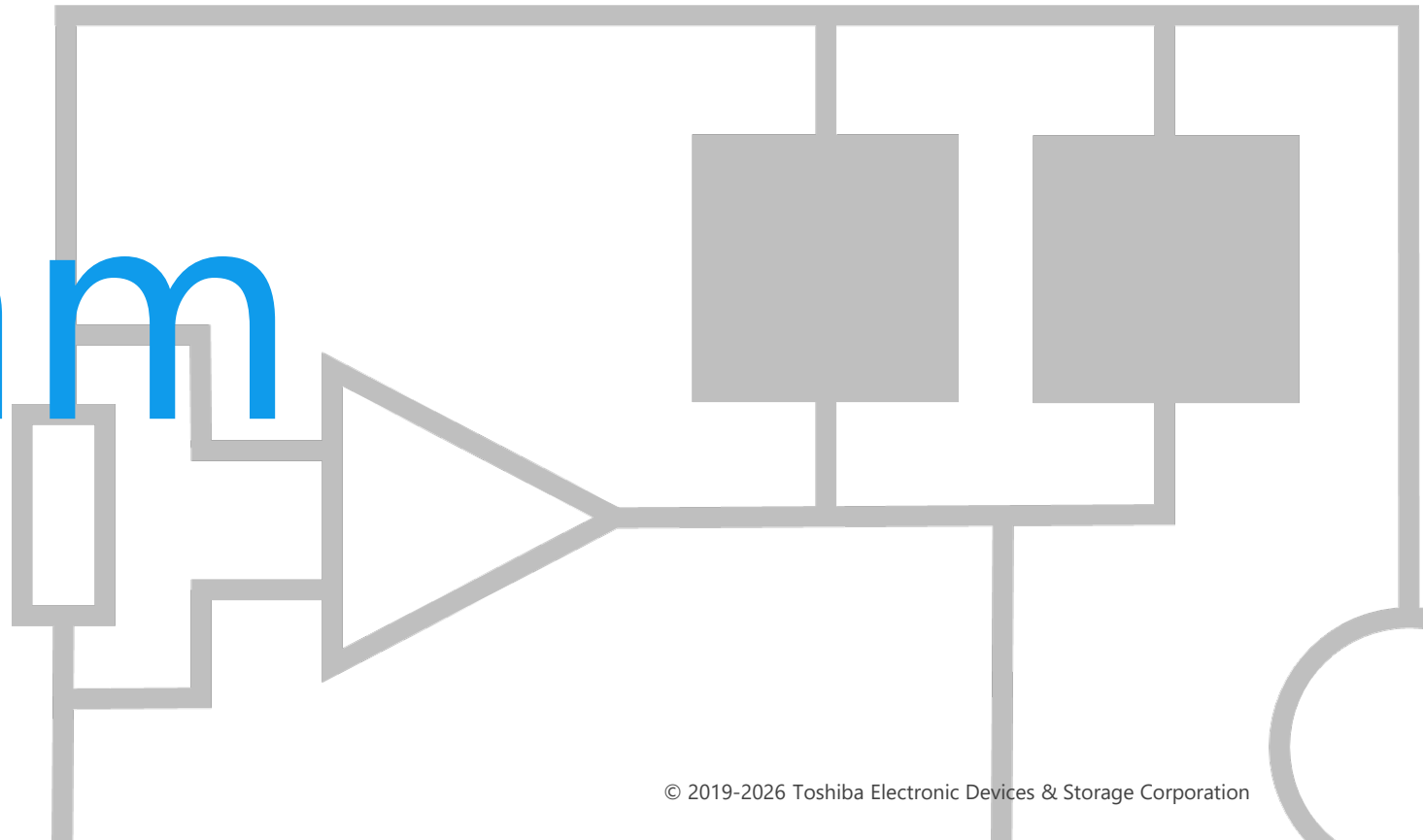




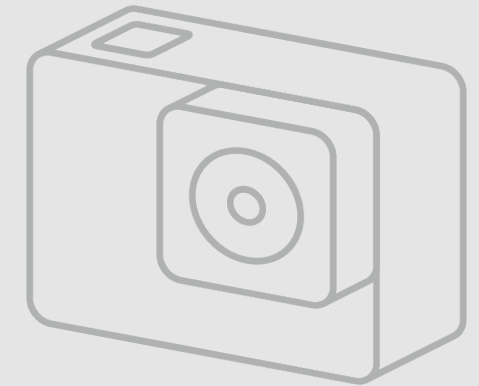
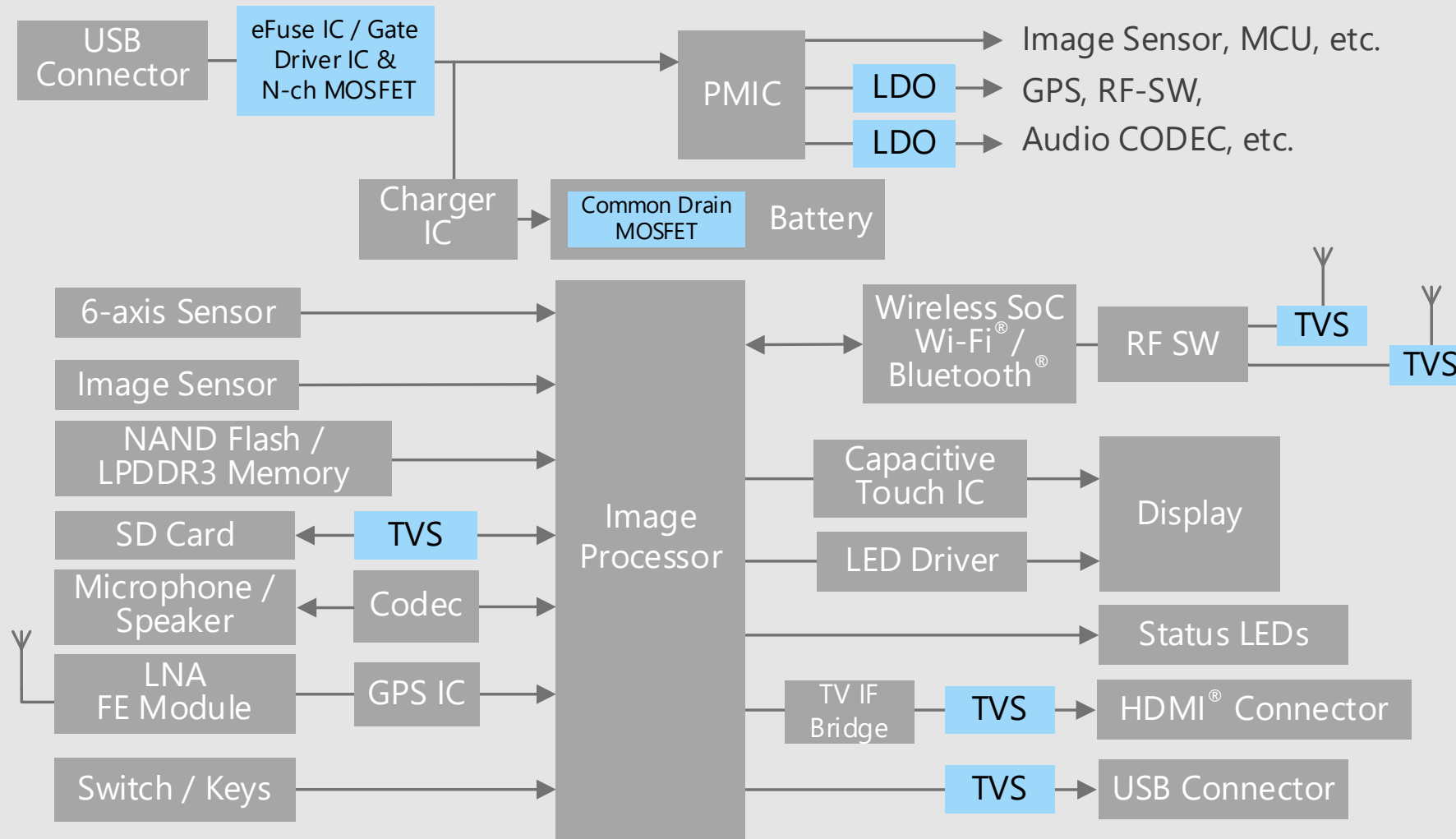
東芝デバイス&ストレージ株式会社では
既存セット設計の深い理解などにより、
新しくセット設計を考えられているお客様へ、
より適したデバイスソリューションをご提供したいと考えています。



Block Diagram

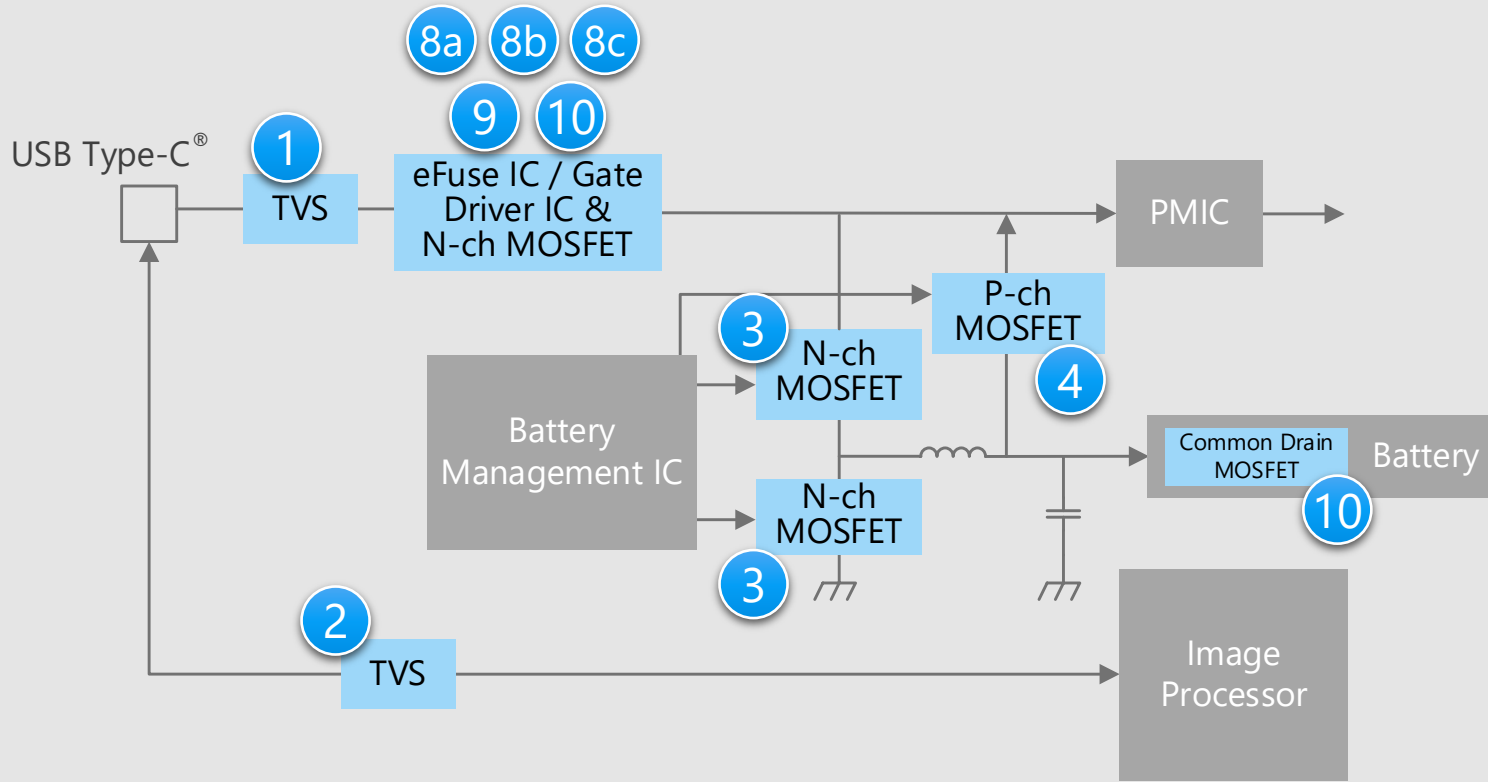


アクションカメラ 全体ブロック図



アクションカメラ USBコネクター周辺部詳細

バッテリーとUSBユニット



※回路図内の番号をクリックすると、詳細説明ページに飛びます

デバイス選定のポイント

- データラインのESD保護には、高速信号伝送へ与える影響が小さい、低容量タイプのTVSダイオードが適しています。
- USBやバッテリー電源の制御には、低オン抵抗のMOSFETが適しています。
- 小型パッケージ品を採用することで基板面積を縮小できます。

東芝からの提案

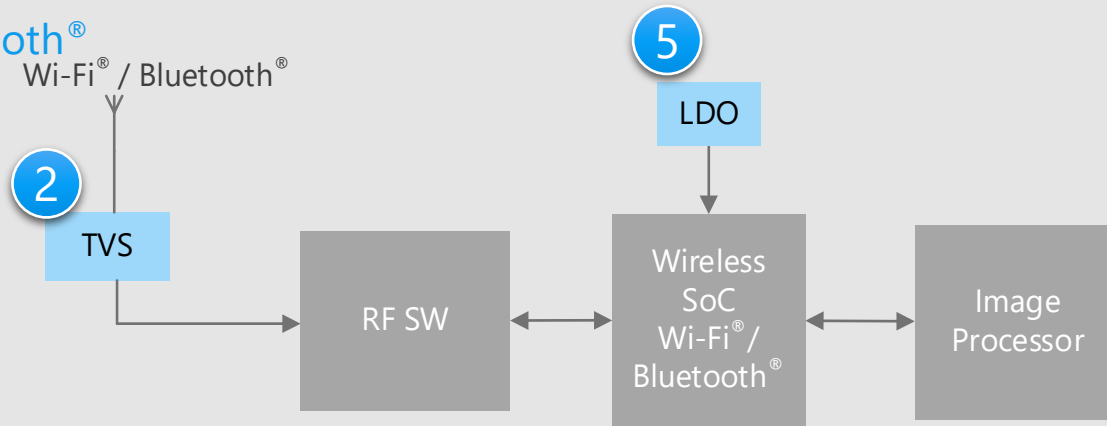
- **小型で高ESD耐量**
TVSダイオード
低容量TVSダイオード
- **小型で低オン抵抗**
小信号MOSFET (N-ch)
小信号MOSFET (P-ch)
- **短絡・過電流・過電圧などに対する保護機能を搭載**
電子ヒューズ (eFuse IC)
- **小型パッケージで過電圧保護機能を搭載**
N-ch MOSFETゲートドライバーIC
- **低オン抵抗で小型パッケージ**
N-ch コモンドレインMOSFET



アクションカメラ RF回路部詳細

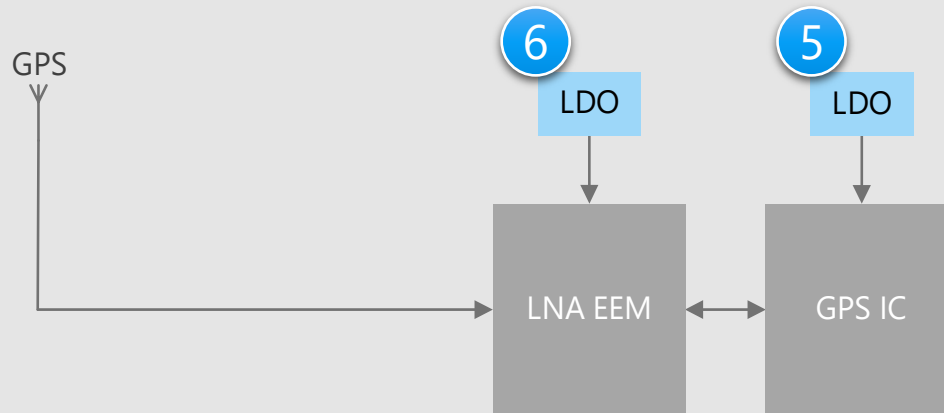
RFユニット

Wi-Fi® / Bluetooth®



RFユニット

GPS



※回路図内の番号をクリックすると、詳細説明ページに飛びます

デバイス選定のポイント

- アンテナからのESD保護には、高周波信号伝送へ与える影響が小さい、低容量タイプのTVSダイオードが適しています。
- 効率よく電圧変換を行うには、低ドロップアウト特性を持つLDOLレギュレーターが適しています。
- 小型パッケージ品を採用することで基板面積を縮小できます。

東芝からの提案

- **小型で高ESD耐量**
低容量TVSダイオード
- **小型で低ドロップアウト特性**
大電流LDOLレギュレーター
小電流LDOLレギュレーター

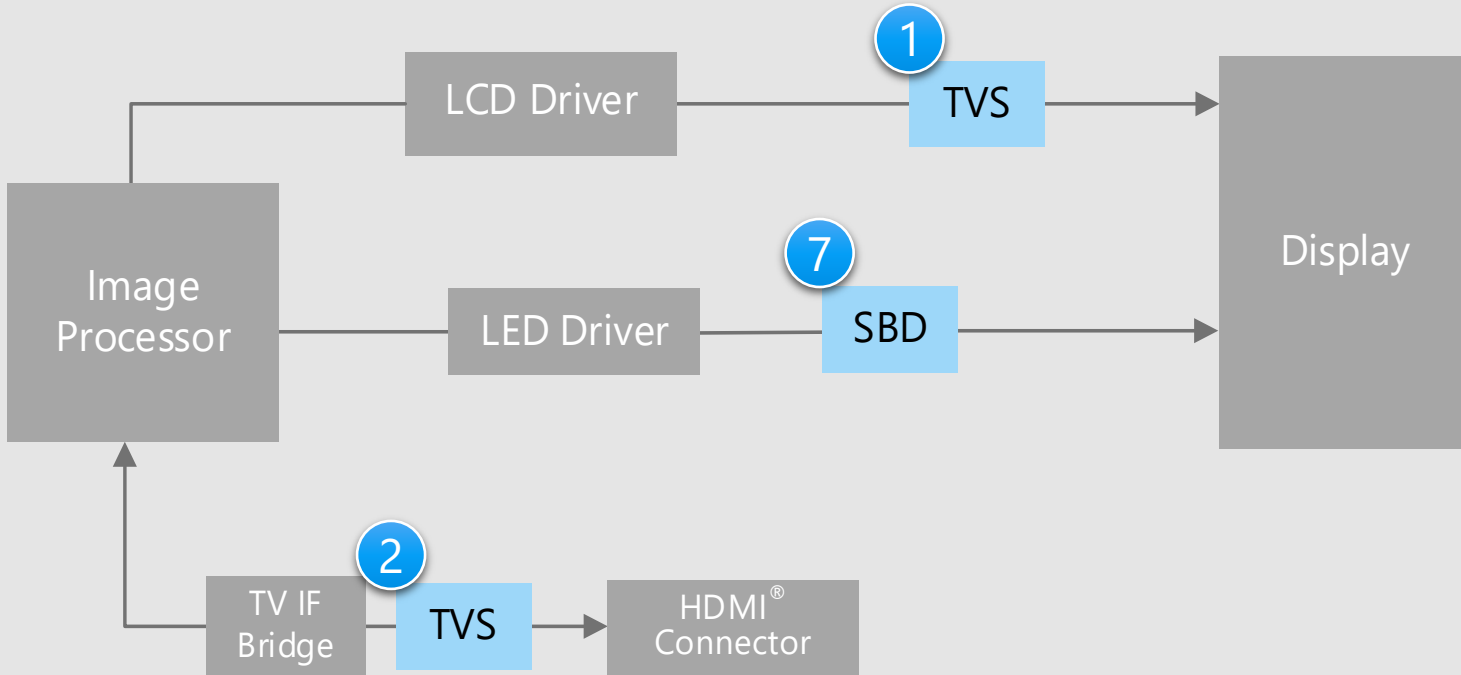
2

5

6

アクションカメラ ディスプレー周辺部詳細

ディスプレイユニット



SBD : Schottky barrier diode

※回路図内の番号をクリックすると、詳細説明ページに飛びます

デバイス選定のポイント

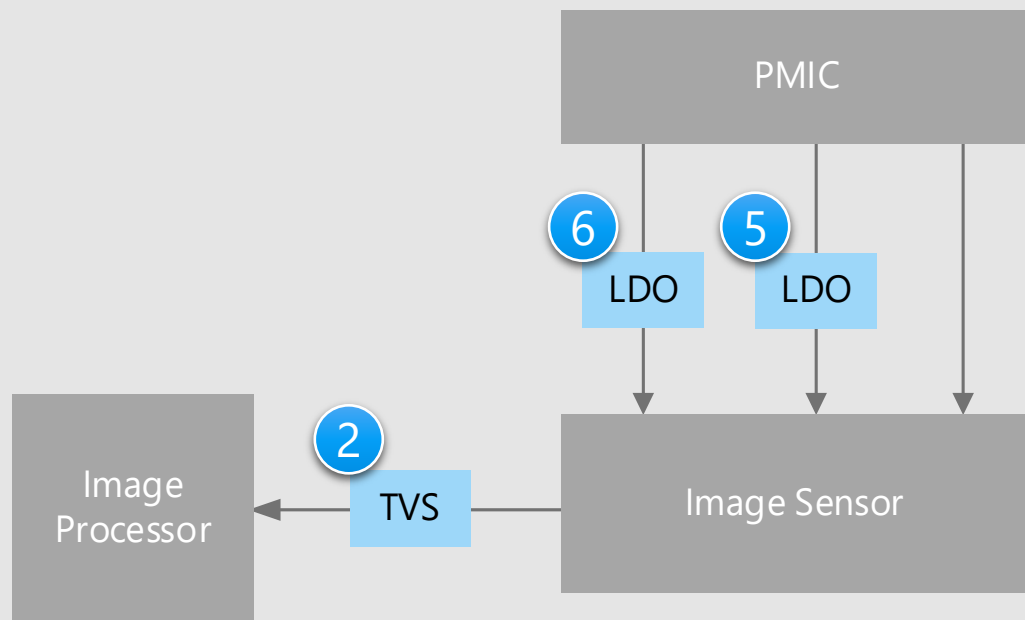
- 低 V_F と低 I_R のショットキーバリアダイオードは、セットの低消費電力化に寄与します。
- データラインのESD保護には、高速信号伝送へ与える影響が小さい、低容量タイプのTVSダイオードが適しています。
- 小型パッケージ品を採用することで基板面積を縮小できます。

東芝からの提案

- **小型で高ESD耐量**
 - TVSダイオード
 - 低容量TVSダイオード
- **小型で低 V_F 、低 I_R 特性**
 - ショットキーバリアダイオード



カメラユニット



※回路図内の番号をクリックすると、詳細説明ページに飛びます

デバイス選定のポイント

- 効率よく電圧変換を行うには、低ドロップアウト特性を持つLDOレギュレーターが適しています。
- データラインのESD保護には、高速信号伝送へ与える影響が小さい、低容量タイプのTVSダイオードが適しています。
- 小型パッケージ品を採用することで基板面積を縮小できます。

東芝からの提案

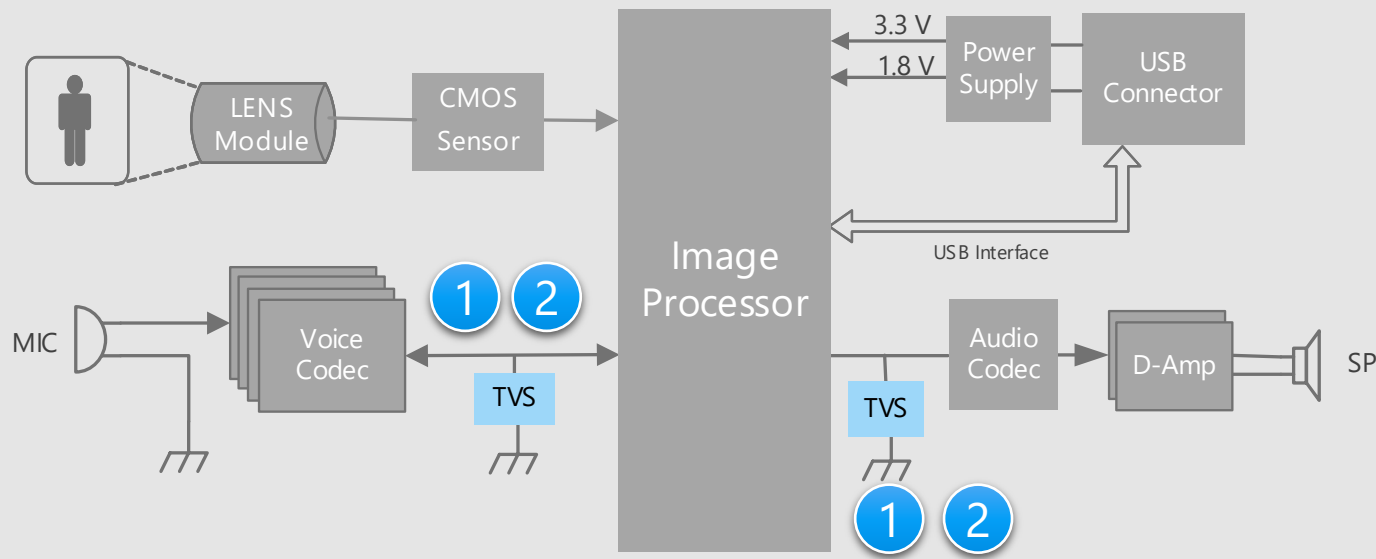
- **小型で高ESD耐量**
低容量TVSダイオード
- **小型で低ドロップアウト特性**
大電流LDOレギュレーター
小電流LDOレギュレーター

2

5

6

画像処理部



※回路図内の番号をクリックすると、詳細説明ページに飛びます

デバイス選定のポイント

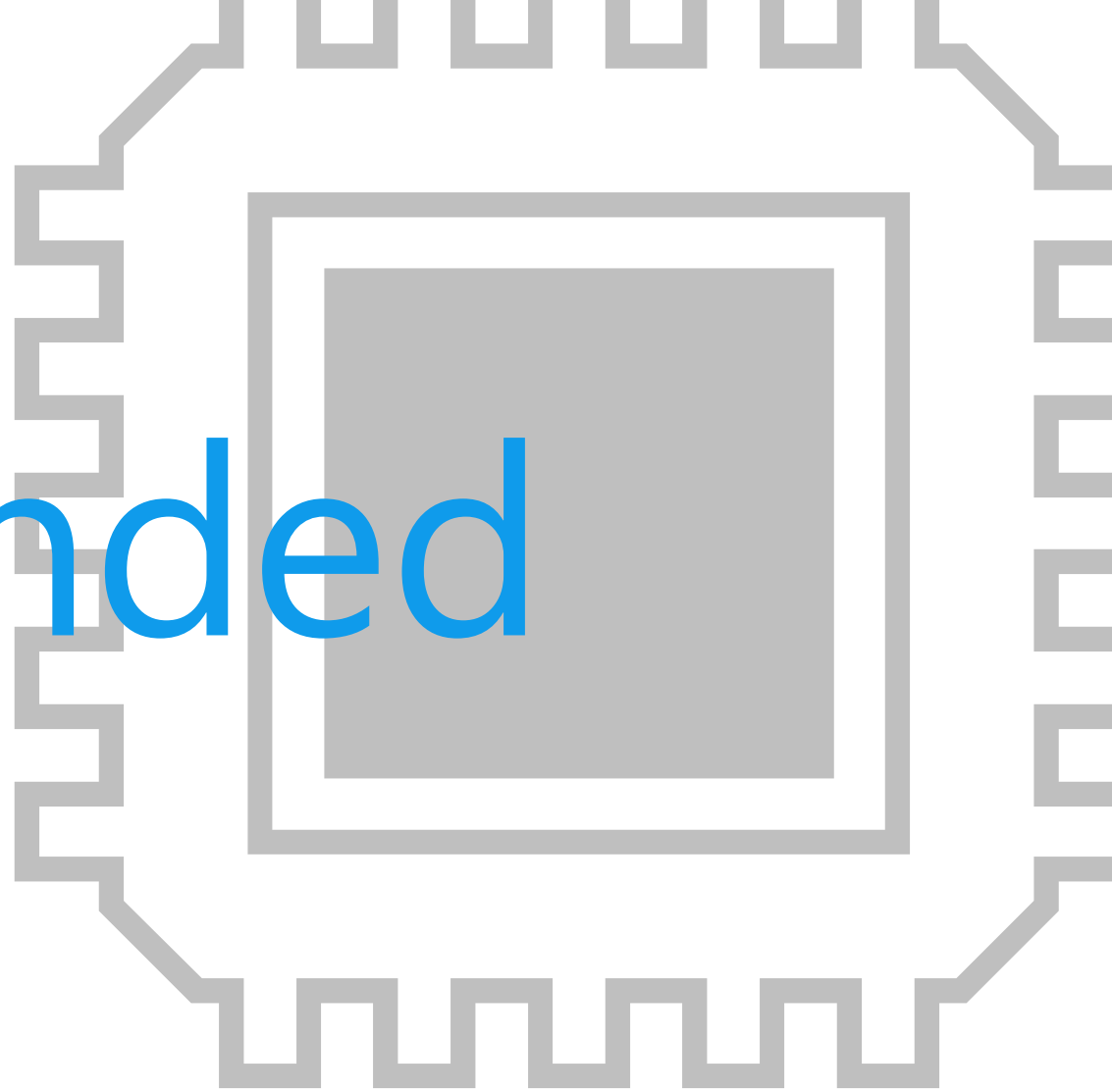
- データラインのESD保護には、高速信号伝送へ与える影響が小さい、低容量タイプのTVSダイオードが適しています。

東芝からの提案

- **小型で高ESD耐量**
TVSダイオード
低容量TVSダイオード



Recommended Devices



お客様の課題を解決するデバイスソリューション

以上のように、アクションカメラの設計には「カメラの高性能化」「セットの低消費電力化」「基板の小型化」が重要であると考え、三つのソリューション視点から製品をご提案します。

カメラの高性能化



セットの低消費電力化



基板の小型化



お客様の課題を解決するデバイスソリューション

低ノイズ
対応

高効率
・
低損失

小型
パッケージ
対応

① TVSダイオード			●
② 低容量TVSダイオード			●
③ 小信号MOSFET (N-ch)		●	●
④ 小信号MOSFET (P-ch)		●	●
⑤ 大電流LDOレギュレーター	●	●	●
⑥ 小電流LDOレギュレーター	●	●	●
⑦ ショットキーバリアダイオード		●	●
⑧ 電子ヒューズ (eFuse IC)		●	●
⑨ N-ch MOSFETゲートドライバーIC		●	●
⑩ N-ch コモンドレインMOSFET		●	●

提供価値

外部端子から侵入する静電気 (ESD) を吸収し、回路の誤動作を防止、およびデバイスを保護します。

1 ESDパルス吸収性を向上

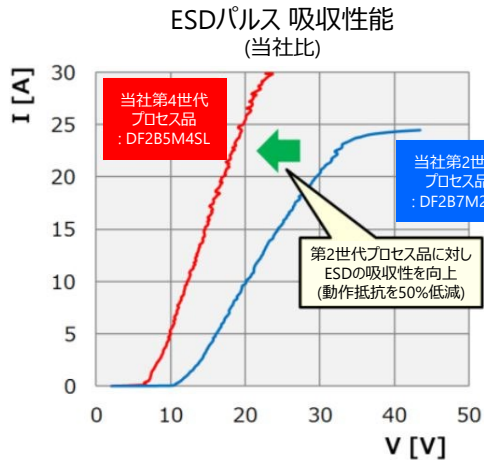
当社従来製品に対し、ESDの吸収性を向上しました。(動作抵抗を50%低減)
低動作抵抗と低容量を両立した製品もあり、高い信号保護性能と信号品質を確保します。

2 低クランプ電圧化によりESDエネルギーを抑制

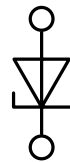
独自の技術により、接続された回路や素子を保護します。

3 高密度実装に好適

多彩な小型パッケージをラインアップしています。

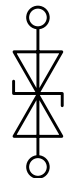


単方向タイプ





ロジック信号などの経路に適しています。
1in1、2in1、4in1、5in1、7in1品のラインアップがあります。

双方向タイプ



オーディオ信号などプラスマイナス両極の信号がある経路に適しています。

ラインアップ

品名	DF2B7BSL	
パッケージ	SL2	 Top view  Bottom view
V_{ESD} [kV]	±30	
V_{RWM} (Max) [V]	5.5	
C_t (Typ.) [pF]	12	
R_{DYN} (Typ.) [Ω]	0.2	

(注) 製品はESD保護用ダイオードであり、ESD保護用以外の用途には使用はできません。

[◆Block Diagram TOPへ戻る](#)

提供価値

低容量タイプのTVSダイオードは、データラインの高速信号伝送へ与える影響が小さいとともに回路の誤動作を防止し、デバイスを保護します。

1 ESDパルス吸収性を向上

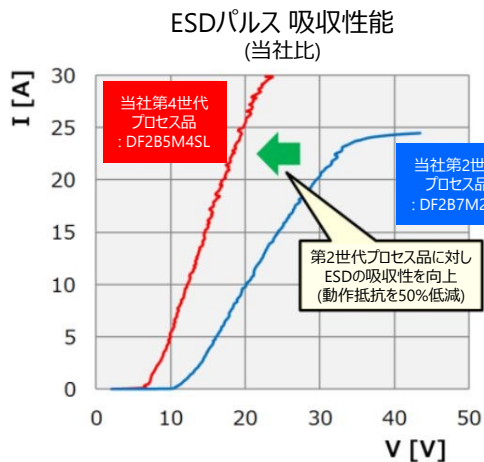
当社従来製品に対し、ESDの吸収性を向上しました。(動作抵抗を50%低減)
低動作抵抗と低容量を両立した製品もあり、高い信号保護性能と信号品質を確保します。

2 低クランプ電圧化によりESDエネルギーを抑制

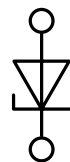
独自の技術により、接続された回路や素子を保護します。

3 高密度実装に好適

多彩な小型パッケージをラインアップしています。

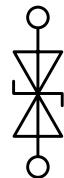


単方向タイプ





ロジック信号などの経路に適しています。
1in1、2in1、4in1、5in1、7in1品のラインアップがあります。

双方向タイプ



オーディオ信号などプラスマイナス両極の信号がある経路に適しています。

ラインアップ

品名	DF2B6M4BSL	DF2B5M4ASL	DF2B6M4ASL	DF2B6M4SL
パッケージ	SL2	 Top view	 Bottom view	
V_{ESD} [kV]	±8	±16	±15	±20
V_{RWM} (Max) [V]	5.5	3.6	5.5	5.5
C_t (Typ.) [pF]	0.12	0.15	0.15	0.2
R_{DYN} (Typ.) [Ω]	1.05	0.7	0.7	0.5

(注) 製品はESD保護用ダイオードであり、ESD保護用以外の用途には使用はできません。

[◆Block Diagram TOPへ戻る](#)

提供価値

パワーマネジメントスイッチなどに適し、セット小型化に貢献します。

1 低い駆動電圧

$V_{GS} = 4.5\text{ V}$ で駆動します。

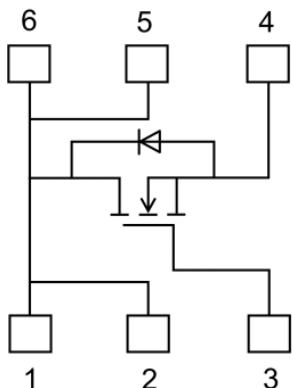
2 低いオン抵抗

ドレイン・ソース間のオン抵抗が低く、発熱と消費電力を抑えることができます。

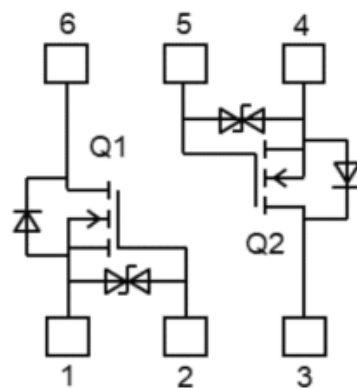
3 小型パッケージ

小型のSOT-1220 (2.0 x 2.0 mm)、SOT-1118 (2.0 x 2.0 mm) パッケージに封止されています。



SSM6K513NUの内部回路構成



SSM6N55NUの内部回路構成



ラインアップ

品名	SSM6K513NU	SSM6N55NU
パッケージ	UDFN6B (SOT-1220)  Bottom view	UDFN6 (SOT-1118)  Bottom view
V_{DSS} [V]	30	30
I_D [A]	15	4
$R_{DS(ON)}$ [mΩ] @ $V_{GS} = 4.5\text{ V}$	Typ.	8.0
	Max	12
極性	N-ch	N-ch x 2

[◆Block Diagram TOPへ戻る](#)

提供価値

パワーマネジメントスイッチなどに適し、セット小型化に貢献します。

1 低い駆動電圧

$V_{GS} = -4.5\text{ V}$ で駆動します。

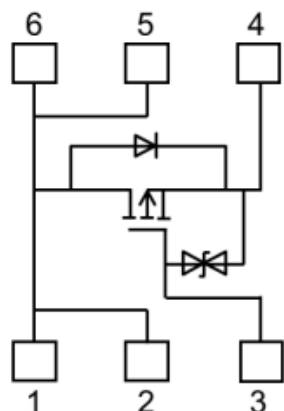
2 低いオン抵抗

ドレイン・ソース間のオン抵抗が低く、発熱と消費電力を抑えることができます。



3 小型パッケージ

小型のSOT-1220 (2.0 x 2.0 mm) パッケージに封止されています。

SSM6J507NUの内部回路構成



ラインアップ

品名	SSM6J507NU		
パッケージ	UDFN6B (SOT-1220)	 Top view	 Bottom view
V_{DSS} [V]	-30		
I_D [A]	-10		
$R_{DS(ON)}$ [m Ω] @ $V_{GS} = -4.5\text{ V}$	Typ.	19	
	Max	28	
極性	P-ch		

[◆Block Diagram TOPへ戻る](#)

提供価値

電源回路で発生するスイッチングノイズを除去し、出力電圧変動の少ない電源を提供します。

1 高いPSRR

当社LDOLレギュレーターは高いPSRR (Power Supply Rejection Ratio: 電源電圧変動除去比) を持ち、電源回路で発生するスイッチングノイズを除去し安定した電源供給を実現します。

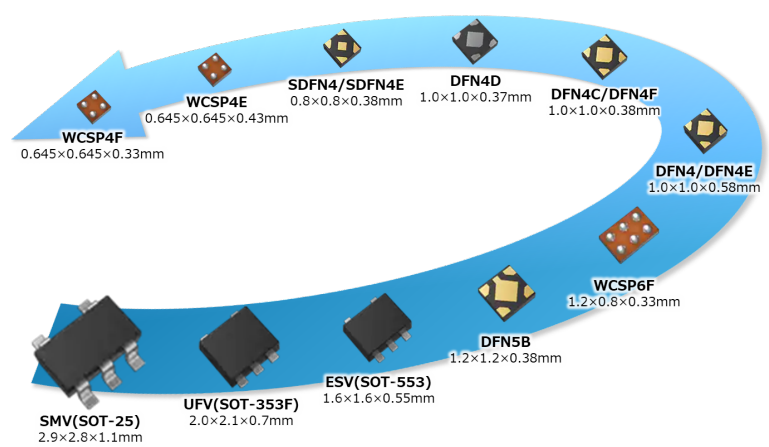
2 低いドロップアウト電圧

当社が独自に開発した最新プロセスにより、ドロップアウト特性を大幅に改善しました。

3 高密度実装に好適

多彩な小型パッケージをラインアップしています。

豊富なパッケージラインアップ



ラインアップ

品名	TCR15AGシリーズ	TCR5BMシリーズ	TCR5RGシリーズ
パッケージ	WCSP6F  Bottom view	DFN5B  Bottom view	WCSP4F  Bottom view
I _{OUT} (Max) [A]	1.5	0.5	0.5
V _{DO} (Typ.) [mV]	120 @I _{OUT} = 1.5 A	100 @I _{OUT} = 500 mA	150 (TCR5RG28A) @I _{OUT} = 500 mA
PSRR (Typ.) [dB] @f = 1 kHz	95	98	100
I _{BIAS(ON)} / I _B (Typ.) [μA]	25	19	7

[◆Block Diagram TOPへ戻る](#)

提供価値

電源回路で発生するスイッチングノイズを除去し、出力電圧変動の少ない電源を提供します。

1 高いPSRR

当社LDOLレギュレーターは高いPSRR (Power Supply Rejection Ratio: 電源電圧変動除去比) を持ち、電源回路で発生するスイッチングノイズを除去し安定した電源供給を実現します。

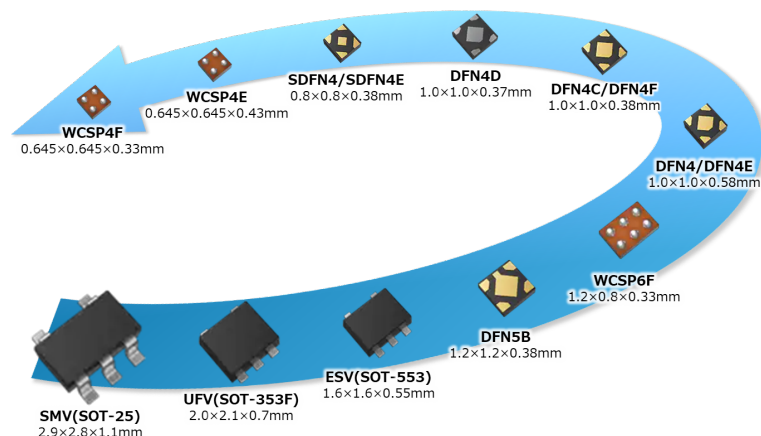
2 低いドロップアウト電圧

当社が独自に開発した最新プロセスにより、ドロップアウト特性を大幅に改善しました。





3 高密度実装に好適

多彩な小型パッケージをラインアップしています。

豊富なパッケージラインアップ



ラインアップ

品名	TCR3RMシリーズ	TCR3UMシリーズ	TCR3UGシリーズ	TCR3DGシリーズ
パッケージ	DFN4C/ DFN4F 	DFN4/ DFN4E 	WCSP4F 	WCSP4E 
I_{OUT} (Max) [A]	0.3	0.3	0.3	0.3
V_{DO} (Typ.) [mV] @ $I_{OUT} = 300$ mA	98 (TCR3RM45A)	196 (TCR3UM33A)	140 (TCR3UG33A/ TCR3UG33B)	195
PSRR (Typ.) [dB] @ $f = 1$ kHz	100	70	70	70
$I_{BIAS(ON)} / I_B$ (Typ.) [μ A]	7	0.34	0.34	65 (TCR3DG18)

[◆Block Diagram TOPへ戻る](#)

提供価値

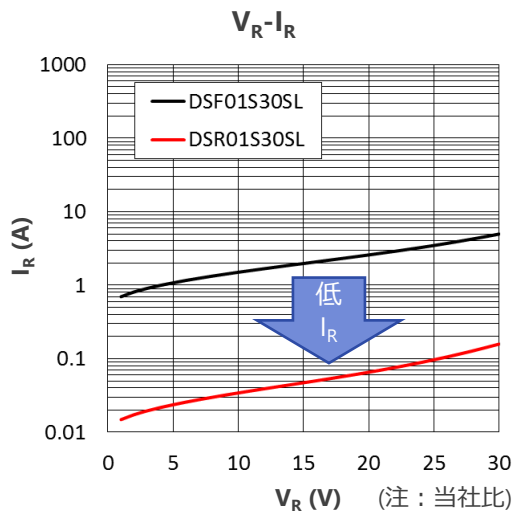
低 V_F と低 I_R 特性を実現し、回路効率の改善に貢献できます。

1 低い V_F と I_R

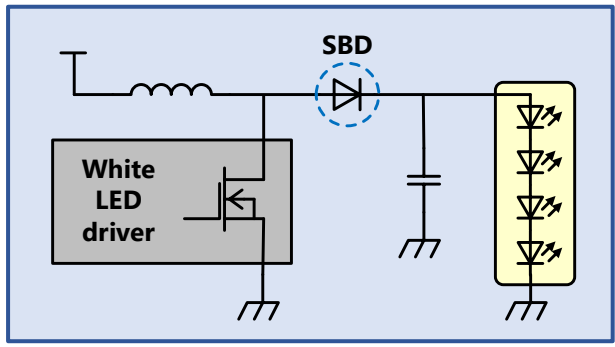
当社従来製品に対し、低 V_F と低 I_R 特性を実現しました。
整流用途で使用した際に、より回路効率を改善できます。

2 高密度実装に好適





多彩な小型パッケージをラインアップしています。



例：LCD back light of up converter circuit



ラインアップ

品名	DSR01S30SL	CLS10F40
パッケージ	SL2  	CL2E  
V_R [V]	30	40
I_O [A]	0.1	1
V_F (Max) [V]	0.62 @ $I_F = 0.1$ A	0.57 @ $I_F = 1$ A
I_R (Max) [μ A]	0.7 @ $V_R = 30$ V	25 @ $V_R = 40$ V

[◆Block Diagram TOPへ戻る](#)

提供価値

繰り返し使用可能な電子ヒューズ (eFuse IC) で過電流や過電圧などの異常状態から回路を保護します。

1 繰り返し使用可能

電子ヒューズ (eFuse IC) は過剰な電流が流れると内部検出回路が動作し内蔵MOSFETをオフします。一度の過電流では破壊されず、繰り返し使用できます。

2 使用方法に適した製品選択可能

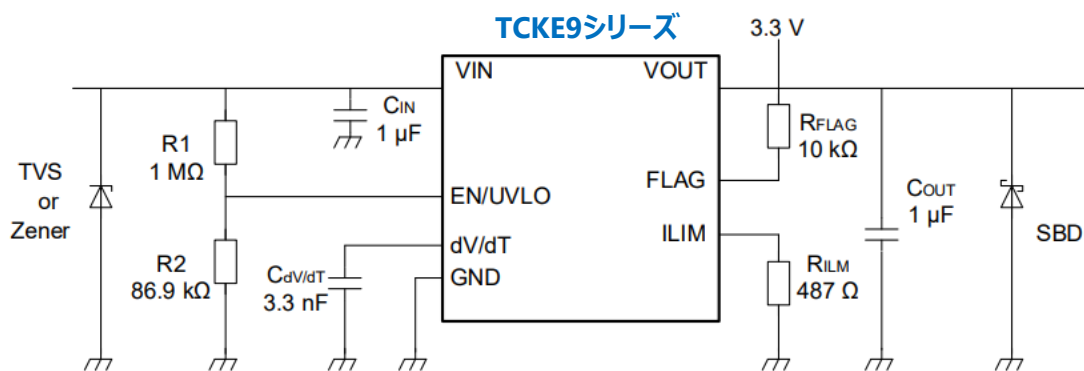
使用方法に適した復帰動作タイプの製品が選択できます。

NA: 自動復帰タイプ
QNA: 自動復帰 + 急速出力ディスチャージ機能付き
NL: ラッチタイプ



3 豊富な保護機能

過電流保護、短絡保護、低電圧誤動作防止、過熱保護などの保護機能を搭載しています。

TCKE9シリーズの周辺回路例



ラインアップ

品名	TCKE903NA/NL/QNA	TCKE905ANA/NL/QNA	TCKE912NA/NL	TCKE920NA/NL
パッケージ	WSON8 2.0 x 2.0 x 0.75 mm  Top view  Bottom view			
V _{IN} [V]	2.7 ~ 23			
R _{ON} (Typ.) [mΩ]	34			
復帰動作タイプ	NA: 自動復帰タイプ (QNA: 急速出力ディスチャージ機能付き), NL: ラッチタイプ			
V _{OVC} (Typ.) [V]	3.87	5.7	13.7	22.2

[◆Block Diagram TOPへ戻る](#)

提供価値

繰り返し使用可能な電子ヒューズ (eFuse IC) で過電流や過電圧などの異常状態から回路を保護します。

1 繰り返し使用可能

電子ヒューズ (eFuse IC) は過剰な電流が流れると内部検出回路が動作し内蔵MOSFETをオフします。一度の過電流では破壊されず、繰り返し使用できます。

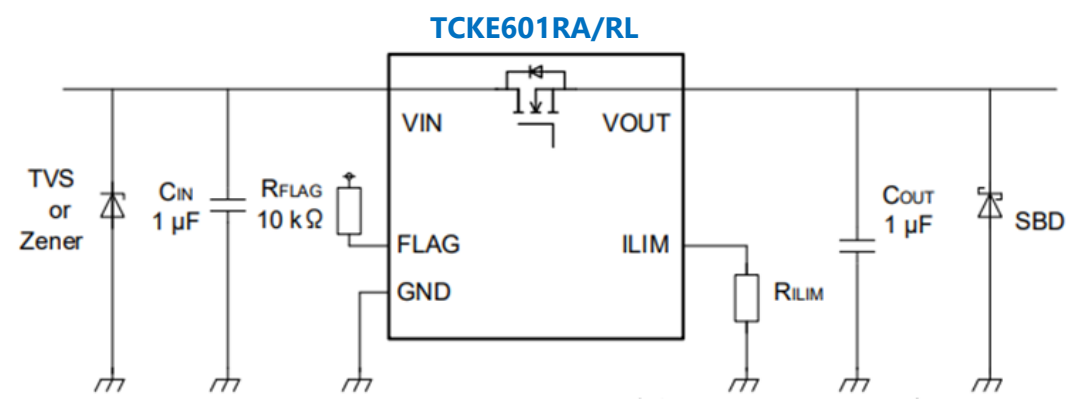
2 機能に応じた製品選択可能

使用方法に適した機能を持つ製品が選択できます。
 FLAG機能: TCKE601RA/RL
 MODE機能 (復帰モードの選択可能): TCKE602
 EN機能: TCKE603RA/RL


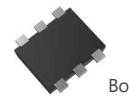
3 豊富な保護機能

過電流保護、短絡保護、低電圧誤動作防止、過熱保護などの保護機能を搭載しています。

TCKE601RA/RLの周辺回路例



ラインアップ

品名	TCKE601RA	TCKE601RL	TCKE602RM	TCKE603RA	TCKE603RL
パッケージ	TSOP6F		 Top view	 Bottom view	
V _{IN} [V]	4.4 ~ 30				
R _{ON} (Typ.) [mΩ]	52				
機能	FLAG機能		MODE機能	EN機能	
復帰モード	オートリトライ	ラッチ	選択式	オートリトライ	ラッチ

[◆Block Diagram TOPへ戻る](#)

提供価値

OVP [注1] 機能を備えたNch-MOSFETゲートドライバーICで、ロードスイッチ回路の小型化と低損失化に貢献します。

[注1] OVP: Over Voltage Protection

1 三種類の接続タイプのN-ch MOSFETを駆動可能

以下の接続方式のMOSFETを駆動できます。

TCK40xG: シングルハイサイド接続

コモンソース接続

TCK42xG: シングルハイサイド接続

コモンドレイン接続

2 広い動作電圧範囲と豊富なOVLO [注2] しきい値電圧ラインアップ

動作電圧範囲 (V_{opr}): 2.7~28 V

最大入力電圧: 40 V

5~24 Vの電源ラインに適した V_{IN_OVLO} [注3]をラインアップしています。

[注2] OVLO: Over Voltage Lock Out

[注3] V_{IN_OVLO} : 入力過電圧保護 (OVLO) 検出しきい値電圧

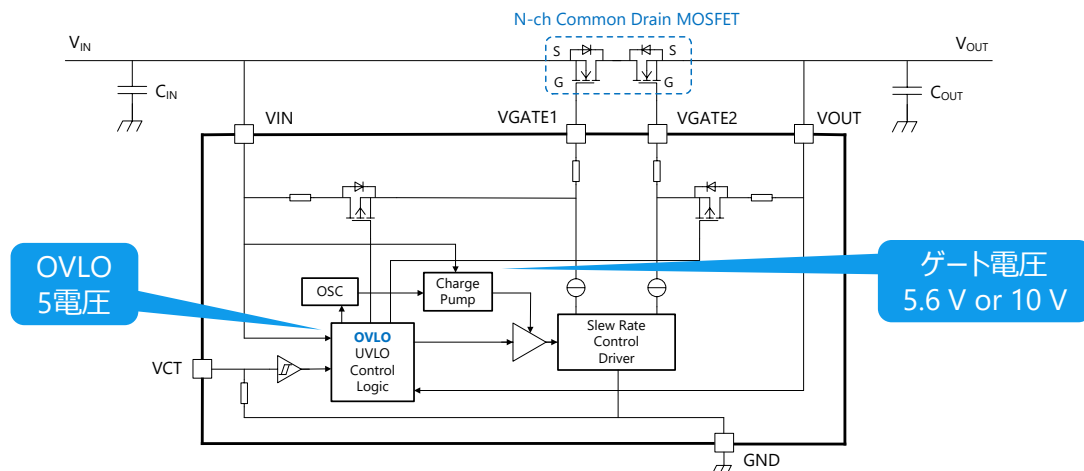
3 小型パッケージ

実装面積を削減し、回路基板の小型化に貢献します。



WCSP6E: 1.2 x 0.8 mm、t: 0.55 mm

WCSP6G: 1.2 x 0.8 mm、t: 0.35 mm

コモンドレインタイプMOSFET用TCK42xG 使用回路例



ラインアップ

製品名	V_{IN_OVLO} Min / Max [V]	V_{GS} Typ. / Max [V]	N-ch MOSFET type can be driven	パッケージ
TCK401G	Over 28	Max 10 ($V_{IN} \geq 12$ V)	Single high side Common Source	WCSP6E 
TCK402G				
TCK420G	26.50 / 28.50	10 / 11 ($V_{IN} \geq 5$ V)	Single high side Common Drain	WCSP6G 
TCK421G	22.34 / 24.05			
TCK422G	13.61 / 14.91			
TCK423G	13.61 / 14.91	5.6 / 6.3		
TCK424G	10.35 / 11.47			
TCK425G	5.76 / 6.87			

◆Block Diagram TOPへ戻る

提供価値

低オン抵抗かつ小型・薄型パッケージのMOSFETで、充放電時の発熱抑制およびセットの小型化に貢献します。

1 低オン抵抗

低抵抗プロセスを適用し、低オン抵抗を実現しました。発熱抑制に貢献します。

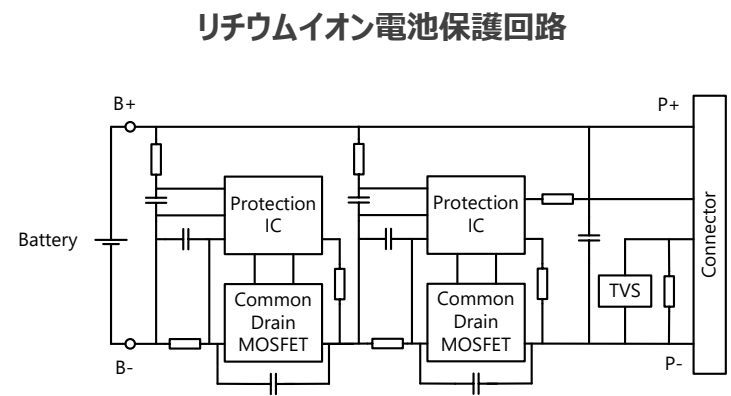
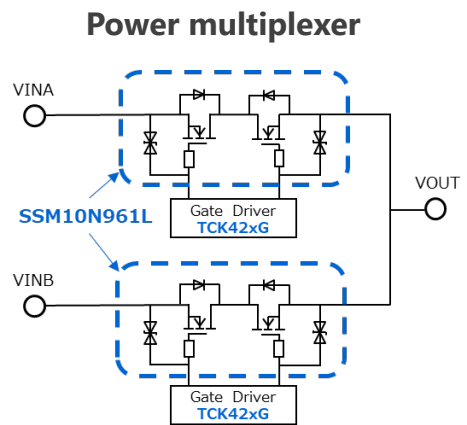
2 小型・薄型パッケージ

デュアル構成でありながら、小型かつ薄型のchipLGAパッケージ製品であり、セットの小型化に貢献します。


3 低いゲート・ソース間漏れ電流

低いゲート・ソース間漏れ電流特性により、低待機電力化が可能となり、バッテリーを使用したセットの長時間動作に貢献します。

コモンドレインMOSFET 使用回路例



ラインアップ

品名	SSM14N956L	SSM10N954L	SSM6N951L	SSM10N961L
パッケージ	 TCSPED-302701	 TCSPAC-153001	 TCSP6A-172101	 TCSPAG-341501
ソース・ソース間電圧 V_{SSS} [V]	12			30
ゲート・ソース間電圧 V_{GSS} [V]	± 8			± 20
ソース電流 (DC) I_S [A]	20.0	13.5	8.0	14.0
$R_{SS(ON)}$ (Typ.) [m Ω] @ $V_{GS} = 3.8$ V	1.1	2.2	4.6	-
$R_{SS(ON)}$ (Typ.) [m Ω] @ $V_{GS} = 10$ V	-	-	-	9.9

[◆Block Diagram TOPへ戻る](#)

製品にご興味をもたれた方、
ご意見・ご質問がございます方、
以下連絡先までお気軽にご連絡ください

連絡先：<https://toshiba.semicon-storage.com/jp/contact.html>



ご利用規約

本規約は、お客様と東芝デバイス&ストレージ株式会社（以下「当社」といいます）との間で、当社半導体製品を搭載した機器を設計する際に参考となるドキュメント及びデータ（以下「本リファレンスデザイン」といいます）の使用に関する条件を定めるものです。お客様は本規約を遵守しなければなりません。

第1条 禁止事項

お客様の禁止事項は、以下の通りです。

1. 本リファレンスデザインは、機器設計の参考データとして使用されることを意図しています。信頼性検証など、それ以外の目的には使用しないでください。
2. 本リファレンスデザインを販売、譲渡、貸与等しないでください。
3. 本リファレンスデザインは、高温・多湿・強電磁界などの対環境評価には使用できません。
4. 本リファレンスデザインを、国内外の法令、規則及び命令により、製造、使用、販売を禁止されている製品に使用しないでください。

第2条 保証制限等

1. 本リファレンスデザインは、技術の進歩などにより予告なしに変更されることがあります。
2. 本リファレンスデザインは参考用のデータです。当社は、データ及び情報の正確性、完全性に関して一切の保証をいたしません。
3. 半導体素子は誤作動したり故障したりすることがあります。本リファレンスデザインを参考に機器設計を行う場合は、誤作動や故障により生命・身体・財産が侵害されることのないように、お客様の責任において、お客様のハードウェア・ソフトウェア・システムに必要な安全設計を行うことをお願いします。また、使用されている半導体素子に関する最新の情報（半導体信頼性ハンドブック、仕様書、データシート、アプリケーションノートなど）をご確認の上、これに従ってください。
4. 本リファレンスデザインを参考に機器設計を行う場合は、システム全体で十分に評価し、お客様の責任において適用可否を判断して下さい。当社は、適用可否に対する責任は負いません。
5. 本リファレンスデザインは、その使用に際して当社及び第三者の知的財産その他の権利に対する保証又は実施権の許諾を行うものではありません。
6. 当社は、本リファレンスデザインに関して、明示的にも黙示的にも一切の保証（機能動作の保証、商品性の保証、特定目的への合致の保証、情報の正確性の保証、第三者の権利の非侵害保証を含むがこれに限らない。）をせず、また当社は、本リファレンスデザインに関する一切の損害（間接損害、結果的損害、特別損害、付随的損害、逸失利益、機会損失、休業損害、データ喪失等を含むがこれに限らない。）につき一切の責任を負いません。

第3条 契約期間

本リファレンスデザインをダウンロード又は使用することをもって、お客様は本規約に同意したものとみなされます。本規約は予告なしに変更される場合があります。当社は、理由の如何を問わずいつでも本規約を解除することができます。本規約が解除された場合は、お客様は本リファレンスデザインを破棄しなければなりません。さらに当社が要求した場合には、お客様は破棄したことを証する書面を当社に提出しなければなりません。

第4条 輸出管理

お客様は本リファレンスデザインを、大量破壊兵器の開発等の目的、軍事利用の目的、あるいはその他軍事情報の目的で使用してはなりません。また、お客様は「外国為替及び外国貿易法」、「米国輸出管理規則」等、適用ある輸出関連法令を遵守しなければなりません。

第5条 準拠法

本規約の準拠法は日本法とします。

第6条 管轄裁判所

本リファレンスデザインに関する全ての紛争については、別段の定めがない限り東京地方裁判所を第一審の専属管轄裁判所とします。

製品取り扱い上のお願い

東芝デバイス&ストレージ株式会社およびその子会社ならびに関係会社を以下「当社」といいます。
本資料に掲載されているハードウェア、ソフトウェアおよびシステムを以下「本製品」といいます。

- 本製品に関する情報等、本資料の掲載内容は、技術の進歩などにより予告なしに変更されることがあります。
- 文書による当社の事前の承諾なしに本資料の転載複製を禁じます。また、文書による当社の事前の承諾を得て本資料を転載複製する場合でも、記載内容に一切変更を加えたり、削除したりしないでください。
- 当社は品質、信頼性の向上に努めていますが、半導体・ストレージ製品は一般に誤作動または故障する場合があります。本製品をご使用頂く場合は、本製品の誤作動や故障により生命・身体・財産が侵害されることのないように、お客様の責任において、お客様のハードウェア・ソフトウェア・システムに必要な安全設計を行うことをお願いします。なお、設計および使用に際しては、本製品に関する最新の情報（本資料、仕様書、データシート、アプリケーションノート、半導体信頼性ハンドブックなど）および本製品が使用される機器の取扱説明書、操作説明書などをご確認の上、これに従ってください。また、上記資料などに記載の製品データ、図、表などに示す技術的な内容、プログラム、アルゴリズムその他応用回路例などの情報を使用する場合は、お客様の製品単独およびシステム全体で十分に評価し、お客様の責任において適用可否を判断してください。
- 本製品は、特別に高い品質・信頼性が要求され、またはその故障や誤作動が生命・身体に危害を及ぼす恐れ、膨大な財産損害を引き起こす恐れ、もしくは社会に深刻な影響を及ぼす恐れのある機器（以下“特定用途”という）に使用されることは意図されていませんし、保証もされていません。特定用途には原子力関連機器、航空・宇宙機器、医療機器（生命直結機器）、車載・輸送機器、防衛関連機器などが含まれますが、本資料に個別に記載する用途は除きます。特定用途に使用された場合には、当社は一切の責任を負いません。なお、詳細は当社営業窓口まで、または当社Webサイトのお問い合わせフォームからお問い合わせください。本製品を分解、解析、リバースエンジニアリング、改造、改変、翻案、複製等しないでください。
- 本製品を、国内外の法令、規則及び命令により、製造、使用、販売を禁止されている製品に使用することはできません。
- 本資料に掲載してある技術情報は、製品の代表的動作・応用を説明するためのもので、その使用に際して当社及び第三者の知的財産権その他の権利に対する保証または実施権の許諾を行うものではありません。
- 別途、書面による契約またはお客様と当社が合意した仕様書がない限り、当社は、本製品および技術情報に関して、明示的にも黙示的にも一切の保証（機能動作の保証、商品性の保証、特定目的への合致の保証、情報の正確性の保証、第三者の権利の非侵害保証を含むがこれに限らない。）をしておりません。
- 本製品にはGaAs（ガリウムヒ素）が使われているものがあります。その粉末や蒸気等は人体に対し有害ですので、破壊、切断、粉碎や化学的な分解はしないでください。
- 本製品、または本資料に掲載されている技術情報を、大量破壊兵器の開発等の目的、軍事利用の目的、あるいはその他軍用途の目的で使用しないでください。また、輸出に際しては、「外国為替及び外国貿易法」、「米国輸出管理規則」等、適用ある輸出関連法令を遵守し、それらの定めるところにより必要な手続を行ってください。
- 本製品のRoHS適合性など、詳細につきましては製品個別に必ず当社営業窓口までお問い合わせください。本製品のご使用に際しては、特定の物質の含有・使用を規制するRoHS指令等、適用ある環境関連法令を十分調査の上、かかる法令に適合するようご使用ください。お客様がかかる法令を遵守しないことにより生じた損害に関して、当社は一切の責任を負いかねます。

TOSHIBA

- * Bluetooth® は Bluetooth SIG Inc. の登録商標です。
- * HDMI、HDMI High-Definition Multimedia Interface、HDMIのトレードドレスおよび HDMIのロゴは、HDMI Licensing Administrator, Inc.の商標または登録商標です。
- * USB Type-C®、USB-C®は、USB Implementers Forumの登録商標です。
- * Wi-Fiは、Wi-Fi Allianceの登録商標です。
- * その他の社名・商品名・サービス名などは、それぞれ各社が商標として使用している場合があります。